



Implanteur ionique moyen courant 200kV

Principales caractéristiques :

Faisceau :

- Énergie : 20 à 400 keV (ion 2 fois chargé) ;
- Courant typique : < 650 μ A (31P+ à 100 keV) ;
- Uniformité de dose : 0,75%, reproductibilité : \pm 1%.

Système de vide :

- Source d'ions : pompe à diffusion ;
- Beam line : pompe cryogénique ($3 \cdot 10^{-7}$ Torr), end station : pompe cryogénique ($3 \cdot 10^{-7}$ Torr) ;

Sources d'ions :

- Type Freeman, équipée d'un four à induction, $T_{\max}=600^{\circ}\text{C}$.

Portes substrats :

- Cryogénique $T = 77\text{K}$, chauffant $T_{\max} = 800^{\circ}\text{C}$.

Éléments disponibles : H, He, C, N, O, Ne, P, Ar, Kr, Xe.

Applications typiques :

- Implantation des semi-conducteurs, gettering, R&D.

Personnes à contacter : Jean-François Barbot, responsable scientifique.
Marc Marteau, responsable technique.